

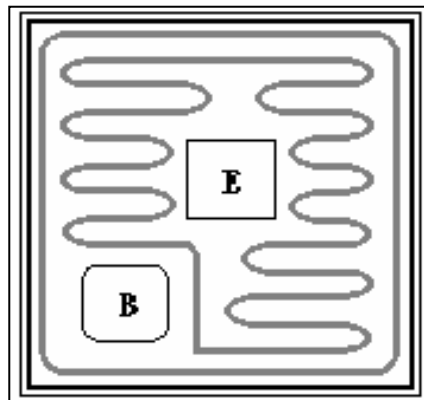


128M 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C060AJ-02
芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$
管芯尺寸： $600 \times 600\mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $130 \times 150\mu\text{m}^2$ ；E 极 $140 \times 130\mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：STC128M，H128M

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92S)

T_{stg} ——贮存温度..... -55~150
 T_j ——结温..... 150
 P_C ——集电极耗散功率..... 400mW
 V_{CBO} ——集电极—基极电压..... 20V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压..... 15V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压..... 6.5V
 I_C ——集电极电流..... 1.5A

电参数 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92S)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	20			V	$I_C=50\mu\text{A}$ ， $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	15			V	$I_C=1\text{mA}$ ， $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6.5			V	$I_E=50\mu\text{A}$ ， $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{\text{CB}}=20\text{V}$ ， $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{\text{EB}}=6\text{V}$ ， $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	150				$V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_C=100\text{mA}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压		0.2	0.3	V	$I_C=500\text{mA}$ ， $I_B=50\text{mA}$
f_T	特征频率		260		MHz	$V_{\text{CE}}=5\text{V}$ ， $I_C=50\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		5		Pf	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$ ， $I_E=0$ ， $f=1\text{MHz}$
R_{ON}	通态电阻		0.6		Ω	$V_{\text{IN}}=0.3\text{V}$ ， $I_B=1\text{mA}$ ， $f=1\text{KHz}$